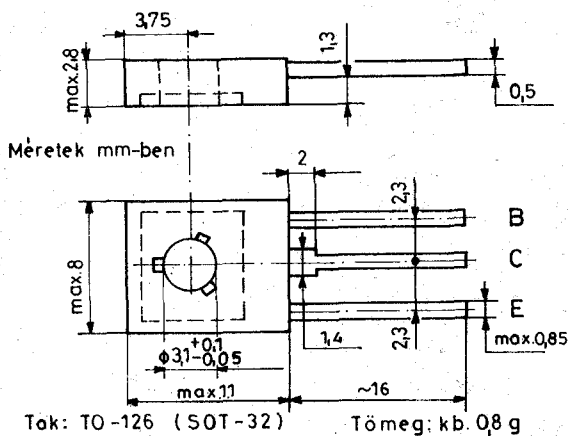


M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT

IV., Fóti út 56.

1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306

BDC 35 szilícium NPN planár epitaxiális RF teljesítmény tranzisztor



Ajánlott alkalmazás
A BDC 35 nagyfrekvenciás szilícium teljesítmény tranzisztor alkalmas 27 MHz-ig teljesítmény erősítőként. Javasoljuk CB-rádiók végerősítő fokozatában, illetve rövidhullámú adók meghajtó fokozataként.

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Ágazat Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).

Schronk László

MAXIMÁLIS HATÁRADATOK	JELÖLÉS	BDC 35	EGYSÉG
Kollektor-bázis feszültség	V_{CB0}	60	V
Kollektor-emitter feszültség	V_{CE0}	35	V
Emitter-bázis feszültség	V_{EB0}	5	V
Kollektor egyenáram	I_C	1	A
Kollektor áram csúcserő	I_{CM}	2	A
TELJES TELJESÍTMÉNYDISSIPÁCIÓ			
$T_{case} = 25^\circ C$	P_{tot}	6	W
Átmenet hőmérséklete	T_j	150	$^\circ C$
Tárolási hőmérséklet	T_s	- 55... +150	$^\circ C$
HŐELLENÁLLÁS			
átmenet és tok között	R_{thjc}	10	k/W

SZTATIKUS JELLEMZŐK $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	JELÖLÉS	BDC 35	EGYSÉG
Kollektor-bázis visszáram $V_{CB} = 50\text{V}$	I_{CBO}	≤ 100	nA
Emitter-bázis visszáram $V_{EB} = 5\text{V}$	I_{EBO}	≤ 100	nA
Kollektor-bázis letörési feszültség $I_C = 10\mu\text{A}$, $I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	≥ 60	V
Kollektor-emitter letörési feszültség $I_C = 10\text{mA}$, $I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	≥ 35	V
Emitter-bázis letörési feszültség $I_E = 10\mu\text{A}$, $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	≥ 5	V
Kollektor-emitter maradék feszültség $I_C = 500\text{mA}$, $I_B = 50\text{mA}$	$V_{CE\text{ sat}}$	$\leq 1,6$	V
Egyenáramu áramerősítési tényező $V_{CE} = 10\text{V}$, $I_C = 1\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$, $I_C = 150\text{mA}$	h_{21E} h_{21E}	≥ 25 ≥ 40	

DINAMIKUS JELLEMZŐK $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	JELÖLÉS	BDC 35	EGYSÉG
Transit frekvencia $V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 30\text{mA}$ $f = 100\text{MHz}$	f_T	200	MHz
Kollektor-bázis kapacitás $V_{CB} = 10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	C_{CBO}	10	pF
Kimenő feszültség a mérőkapcsolásban $V_{CC} = 9\text{V}$, $f = 27\text{MHz}$ $V_i = 2,8\text{V}$, $R_{in} = R_{out} = 50\text{ ohm}$	V_O	10	V



M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT